特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)



(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 904195 ·	今後の手続きについては	へては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP2004/008604 ´	国際出願日 (日.月.年) 18,0	6.2004	優先日 (日.月.年) ³	30.06.2	003,
国際特許分類(IPC) Int. Cl	' H01S5/022				
出願人(氏名又は名称) シャープ	株式会社			-	
1. この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条 (PCT36条) の	の規定に従い送付する。			 ある。 ·	
	っている。 2 ページである。.	/			
x 補正されて、この報告の基本 囲及び/又は図面の用紙(第1欄4.及び補充欄に示	PCT規則70. 16及び実施	細則第607号	参照)		
国際予備審査機関が認定し		, SESKILING V			
b 電子媒体は全部で 配列表に関する補充欄に示す ブルを含む。(実施細則第8		メ取り可能な形式		は配列表に関連	-
4. この国際予備審査報告は、次の内容				·	
第IV欄 発明の単一性の	E又は産業上の利用可能性 O欠如 2)に規定する新規性、進 対及び説明 C献				それを裏付
国際予備審査の請求書を受理した日 01.12.2004	国[紫予備審査報告を	を作成した日 28.03.20	0 5	·
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4	番 3 号	許庁審査官(権阿吉野 三第		2 K	9010

- 1	
- 1	
- 1	
- 4	
1	ì
ુ	
- 1	
,	
	t
	١
	•
	۰

第1欄	報告の基礎	
1. 20)国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか	2、国際出願の言語を基礎とした。
	この報告は、 語による翻訳文を それは、次の目的で提出された翻訳文の言語であ] PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査] PCT規則12.4にいう国際公開] PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査	ర .
	の報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第69 え用紙は、この報告において「出願時」とし、この	条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され D報告に添付していない。)
	出願時の国際出願書類	
х	明細書 第 <u>1-16</u> ページ、 第 ページ*、 第 ページ*、	出願時に提出されたもの 一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一
×	請求の範囲 第 <u>2-7</u> 項、 第 項*、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの
	第 <u>1</u> 項*、 第 <u></u>	01.12.2005 付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
x	第 ページ/図*、 第 ページ/図*、	出願時に提出されたもの
	配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充欄を参照すること。	
3.	補正により、下記の書類が削除された。	
	明細書請求の範囲第図面配列表(具体的に記載すること)配列表に関連するテーブル(具体的に記載	ページ 項 ページ/図 すること)
4.	」この報告は、補充欄に示したように、この報告 えてされたものと認められるので、その補正が	に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超 されなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))
	 関細費 請求の範囲 図面 配列表(具体的に記載すること) 配列表に関連するテーブル(具体的に記載 	ページ 項 ページ/図 すること)
* 4.	に該当する場合、その用紙に "superseded" と記	己入されることがある。

第 V		見性、進歩性 ルを裏付けるこ		についての法第12	·条 (PCT35条(2))	に定める見解、	
1.	見解						
	新規性	(N)	請求の範囲請求の範囲	1-7			有 無
	進歩性	(1S)	請求の範囲 請求の範囲	1-7			有 無
	産業上の	の利用可能性	(IA) 請求の範囲 請求の範囲	1-7			有 無

文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献 1: JP 2003-101113 A(シャープ株式会社), 2003. 04. 04, 全文, 全図 & US 2003/67950 A1 /

文献2:JP 2002-134822 Å(シャープ株式会社), 2002.05.10, 全文, 全図

文献 3: JP 2001-94215/A(三洋電機株式会社), 2001. 04. 06, [0007]-[0015], 図11

文献 4: JP 2001-274140 A(松下電器産業株式会社), 2001. 10.05,

[0029]-[0033], 図3

文献 5 : JP 2002-261326 (A (名古屋工業大学長), 2002. 09. 13. [0012]-[0016]

文献1には、発光素子チップ, サブマウント, ステムから構成される半導体発光 装置が記載されている。

文献2には、n型窒化物系半導体導電基板の電極構造が記載されている。

文献3には、A1Nサブマウントが記載されている。

文献4,5には、オーミック電極形成の前処理が記載されている。

・請求の範囲1,3-6:文献1,2 文献1の【0038】には「熱伝導率が大きい材質は、放熱特性が良好であり好ましい」と記載されており、導電性基板を形成する材料よりも高い熱伝導率を有する材 料でサブマウントを形成することになんら困難性は認められない。

・請求の範囲2:文献1,3

サブマウント材料としてAlNは周知である。

・請求の範囲7:文献1,4-5 オーミック電極形成の前に電極形成面の状態を良好とする前処理を行うことは周 知技術である。